



中国科学院科学出版基金资助出版

半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 21 卷 第 5 期 2000 年 5 月

目 次

研究快报

- High Efficiency Al-Free 980nm InGaAs/InGaAsP/InGaP Strained Quantum Well Lasers
 XU Zun-tu(徐遵图), YANG Guo-wen(杨国文),
 ZHANG Jing-ming(张敬明), MA Xiao-yu(马晓宇), XU Jun-ying(徐俊英),
 SHEN Guang-di(沈光地) and CHEN Liang-hui(陈良惠) (417)
- Transit Properties of High Power Ultra-Fast Photoconductive Semiconductor Switch
 SHI Wei(施 卫), ZHAO Wei(赵 卫), SUN Xiao-wei(孙小卫) and Lam Yee Loy (421)
- Epitaxial Growth of 150mm Silicon Epi-Wafers for Advanced IC Applications WANG
 Qi-yuan(王启元), CAI Tian-hai(蔡田海), YU Yuan-huan(郁元桓) and LIN Lan-ying(林兰英) (426)
- Unified MOSFET Short Channel Factor Using Variational Method
 CHEN Wen-song(陈文松), TIAN Li-lin(田立林) and LI Zhi-jian(李志坚) (431)

研究论文

- GaN 的 RBS/沟道、X 射线双晶衍射和光致发光谱
 姚冬敏 辛 勇 王 立 李述体 熊传兵 彭学新 刘念华 江风益 (437)
- MOCVD 与 MBE 生长 GaAs/AlGaAs 量子阱材料的红外探测器特性比较
 李 娜 李 宁 陆 卫 冀红飞
 陈张海 刘兴权 沈学础 H. H. Tan Lan Fu C. Jagadish M. B. Johnston M. Gal (441)
- 微波低噪声 SiGe HBT 的研制 钱 伟 张进书 贾宏勇 林惠旺 钱佩信 (445)
- 深亚微米 SOI 栅控混合管(GCHT)的准二维电流解析模型 黄 如 王阳元 (451)
- 采用 CoSi₂ SALICIDE 结构 CMOS/SOI 器件辐照特性的实验研究 张 兴 黄 如 王阳元 (460)
- 极细沟道 NMOSFET 中的大幅度随机电信号噪声
 卜惠明 施 毅 顾书林 袁晓利 吴 军 韩 平 张 荣 郑有焯 (465)
- N⁻掺杂浓度对小尺寸 nMOSFETs 热载流子寿命的影响 张 炯 李瑞伟 (469)
- 超薄外延 CoSi₂/n-Si 的肖特基势垒接触特性 屈新萍 茹国平 徐蓓蕾 李炳宗 (473)
- 垂直入射 Si_{0.7}Ge_{0.3}/Si 多量子阱光电探测器
 李 成 杨沁清 王红杰 罗丽萍 成步文 余金中 王启明 (480)
- 用于共振腔光电探测器的 Si 基 Bragg 反射器
 李 成 杨沁清 朱家廉 王红杰 成步文 余金中 王启明 王鲁峰 彭 晔 (483)
- 平面阵列光学波导模式特性及其光强传输分析
 雷红兵 欧海燕 杨沁清 胡雄伟 余金中 王启明 (486)
- 常数除法器的设计及其 BIST 实现 丁保延 章倩苓 (491)
- 边界元法在数模混合集成电路衬底耦合参数提取中的应用 吴 智 黄均鼎 唐璞山 (496)
- 测定硅各向异性腐蚀速率分布的新方法 杨 恒 鲍敏杭 沈绍群 李昕欣 张大成 武国英 (504)
- 半导体硅片的 p-n 结和铜沉积行为的电化学研究 程 璇 林昌健 (509)
- LPCVD 氮化硅薄膜的室温可见光发射
 刘渝珍 石万全 韩一琴 刘世祥 赵玲莉 孙宝银 叶甜春 陈梦真 (517)